


**Netz-Thyristor-Modul**  
**Phase Control Thyristor Module**
**TT162N**
**TT162N**  
**TT162N...-K**
**TD162N**  
**TD162N...-A**
**DT162N**
**Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**

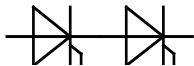
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	1200	1400 1600	V V
Vorwärts-Stoßspitzenspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	$V_{\text{DSM}}$	1200	1400 1600	V V
Rückwärts-Stoßspitzenspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	$V_{\text{RSM}}$	1300	1500 1700	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		$I_{\text{TRMSM}}$		260	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{TAVM}}$		162	A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$	$I_{\text{TSM}}$		5200 4400	A A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$	$I^2t$		135000 97000	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{ Hz}$ , $i_{\text{GM}} = 0,6\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$		150	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 6.Kennbuchstabe / 6 <sup>th</sup> letter C 6.Kennbuchstabe / 6 <sup>th</sup> letter F	$(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$		500 1000	$\text{V}/\mu\text{s}$ $\text{V}/\mu\text{s}$

## Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, i_{\text{T}} = 500\text{ A}$	$V_{\text{T}}$	max.	1,41	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$V_{(\text{TO})}$		0,85	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$r_{\text{T}}$		0,95	$\text{m}\Omega$
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{ V}$	$I_{\text{GT}}$	max.	150	$\text{mA}$
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{ V}$	$V_{\text{GT}}$	max.	2	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 6\text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$I_{\text{GD}}$	max. max.	10 5	$\text{mA}$ $\text{mA}$
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$V_{\text{GD}}$	max.	0,25	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{ V}, R_{\text{A}} = 5\ \Omega$	$I_{\text{H}}$	max.	200	$\text{mA}$
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 10\ \Omega$ $i_{\text{GM}} = 0,6\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}$ , $t_{\text{g}} = 20\ \mu\text{s}$	$I_{\text{L}}$	max.	800	$\text{mA}$
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$ $V_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, V_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$	max.	30	$\text{mA}$
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $i_{\text{GM}} = 0,6\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}$	$t_{\text{gd}}$	max.	3	$\mu\text{s}$

prepared by:	C.Drilling	date of publication:	04.07.02
approved by:	J.Novotny	revision:	1


**Netz-Thyristor-Modul**  
**Phase Control Thyristor Module**
**TT162N**
**Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**


Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\max}$ , $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{ V}$ , $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$ , $-di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ 5.Kennbuchstabe / 5 <sup>th</sup> letter O	$t_q$	typ.	200	$\mu\text{s}$
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}$ , $t = 1\text{ min}$ RMS, $f = 50\text{ Hz}$ , $t = 1\text{ sec}$	$V_{ISOL}$		2,5 3,0	kV kV

**Thermische Eigenschaften / Thermal properties**

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ\text{ sin}$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ\text{ sin}$ pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC	$R_{thJC}$	max.	0,100 0,200 0,096 0,192	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module pro Zweig / per arm	$R_{thCH}$	max.	0,03 0,06	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\max}$		125	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$		-40...+125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$		-40...+130	$^\circ\text{C}$

**Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties**

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex				Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact					
Innere Isolation internal insulation				AIN	
Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse mounting torque	Toleranz / Tolerance $\pm 15\%$	M1		6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / Tolerance $\pm 10\%$	M2		6	Nm
Steueranschlüsse control terminals	DIN 46 244			A 2,8 x 0,8	
Gewicht weight		G	typ.	310	g
Kriechstrecke creepage distance				15	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50\text{ Hz}$			50	$\text{m}/\text{s}^2$
	file-No.			E 83336	

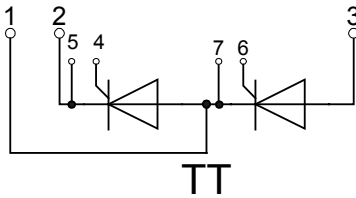
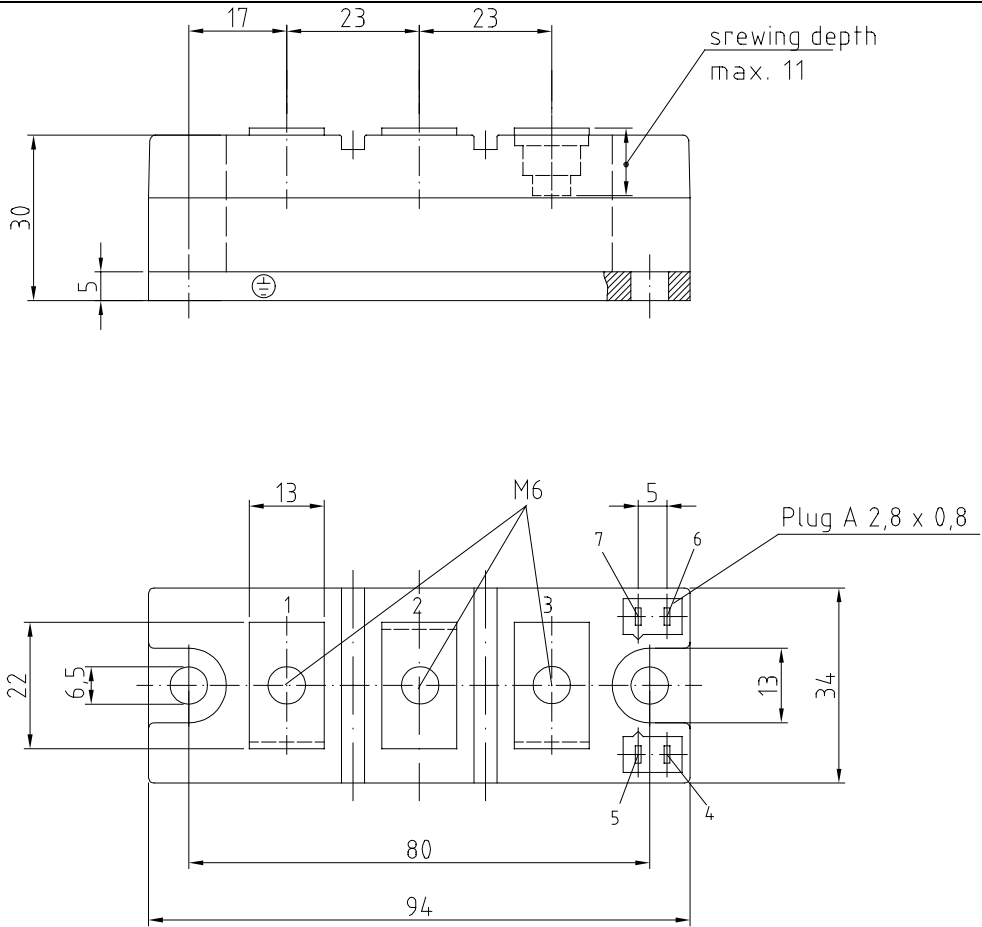
Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Es gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

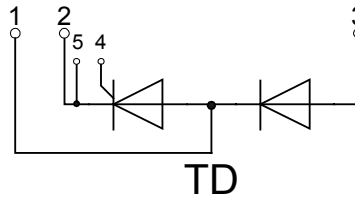


Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

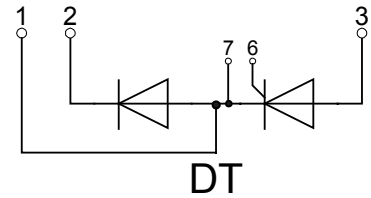
**TT162N**



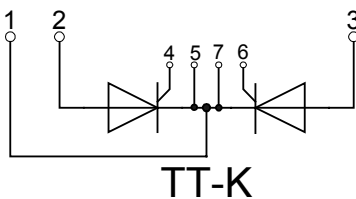
TT



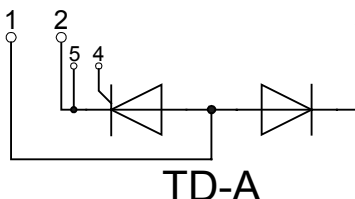
TD



DT



TT-K



TD-A